








	<h2 style="color: red;">FQD24N08TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD24N08TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD24N08TF.pdf 2.FQD24N08TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12401 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD24N08TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12401 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 9.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD24N08TF ist neu im Original, Suche FQD24N08TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD24N08TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD24N08TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD24N08TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD24N08 FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD24N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>
 <p>FQD2N100 FAIRCHILD FQD2N100 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD25N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO252</p>	 <p>FQD20N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N60CTM	↔ FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TF	D FQD1N60TM	↔ FQD1N60TM
⊣ FQD1N80TM	⊗ FQD1N80TM	D FQD1P50TM	⇒ FQD1P50TM	↔ FQD20N06
⊗ FQD20N06-NL	⊣ FQD20N06L	⊗ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM
D FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTF	⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU
⇒ FQD20N06TF	↔ FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD20N06TM	↔ FQD24N08
↔ FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TM	D FQD24N08TM	⊗ FQD2N100	⊣ FQD2N100TM
⊗ FQD2N100TM	D FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM	↔ FQD2N40TM	↔ FQD2N50B
⊣ FQD2N50C	⊗ FQD2N50TF	↔ FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM
⊗ FQD2N60A	⊣ FQD2N60C	⊗ FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF-NL
↔ FQD2N60CTF_F080	⊗ FQD2N60CTF_F080	⊣ FQD2N60CTM	⊗ FQD2N60CTM	↔ FQD2N60TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited